

规格书

2 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC

2 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC



目 录

1.	概述	4
2.	特点	4
3.	应用	4
4.	方框图	5
5.	订货信息	6
6.	产品目录	6
7.	封装、脚位及标记信息	7
8.	绝对最大额定值	7
9.	电气特性	8
10.	电池保护IC应用电路示例	9
11.	工作说明	10
11.1.	正常工作状态	10
11.2.	过充电状态	10
11.3.	过放电状态及休眠状态	10
11.4.	放电过流状态(放电过流检测功能和负载短路检测功能)	11
11.5.	充电过流状态	11
12.	特性(典型数据)	12
13.	封装信息	15
13.1.	SOT-23-6(第一种)	15
13.2.	SOT-23-6(第二种)	16
11	修订记录	17

2 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC



注意:

- 1、本说明书中的内容,随着产品的改进,有可能不经过预告而更改。请客户及时到本公司网站下载更新 http://www.hycontek.com。
- 2、本规格书中的图形、应用电路等,因第三方工业所有权引发的问题,本公司不承担其责任。
- 3、本产品在单独应用的情况下,本公司保证它的性能、典型应用和功能符合说明书中的条件。当使用 在客户的产品或设备中,以上条件我们不作保证,建议客户做充分的评估和测试。
- 4、请注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件,使 IC 内的功耗不超过封装的容许功耗。对于 客户在超出说明书中规定额定值使用产品,即使是瞬间的使用,由此所造成的损失,本公司不承担 任何责任。
- 5、本产品虽内置防静电保护电路,但请不要施加超过保护电路性能的过大静电。
- 6、本规格书中的产品,未经书面许可,不可使用在要求高可靠性的电路中。例如健康医疗器械、防灾器械、车辆器械、车载器械及航空器械等对人体产生影响的器械或装置,不得作为其部件使用。
- 7、本公司一直致力于提高产品的质量和可靠度,但所有的半导体产品都有一定的失效概率,这些失效 概率可能会导致一些人身事故、火灾事故等。当设计产品时,请充分留意冗余设计并采用安全指标, 这样可以避免事故的发生。
- 8、本规格书中内容,未经本公司许可,严禁用于其它目的之转载或复制。



1. 概述

HY2120 系列 IC,内置高精度电压检测电路和延时电路,是用于 2 节串联锂离子/锂聚合物可再充电电池的保护 IC。

此系列IC适合于对2节串联可再充电锂离子/锂聚合物电池的过充电、过放电和过电流进行保护。

2. 特点

HY2120全系列IC具备如下特点:

(1) 高精度电压检测电路

● 过充电检测电压 V_{CUn} (n=1, 2)	4.10V~4.50V	精度 ±25mV
● 过充电释放电压 V _{CRn} (n=1, 2)	3.90V~4.30V	精度 ±50mV
● 过放电检测电压 V_{DLn} (n=1, 2)	2.00V~3.20V	精度 ±80mV
● 过放电释放电压 V _{DRn} (n=1, 2)	2.30V~3.40V	精度 ±100mV
● 放电过流检测电压	(可选择)	
● 充电过流检测电压	(可选择)	精度±30mV
● 负载短路检测电压	1.0V (固定)	精度±0.4V

(2) 各延迟时间由内部电路设置(不需外接电容)

•	过充电检测延迟时间	典型值 1000ms
•	过放电检测延迟时间	典型值 110ms
•	放电过流检测延迟时间	典型值 10ms
•	充电过流检测延迟时间	典型值 7ms
•	负载短路检测延迟时间	典型值 250µs

(3) 低耗电流

● 工作模式 典型值 5.0µA , 最大值 9.0µA (VDD=7.8V)

◆ 休眠模式 最大值 0.1µA (VDD=4.0V)

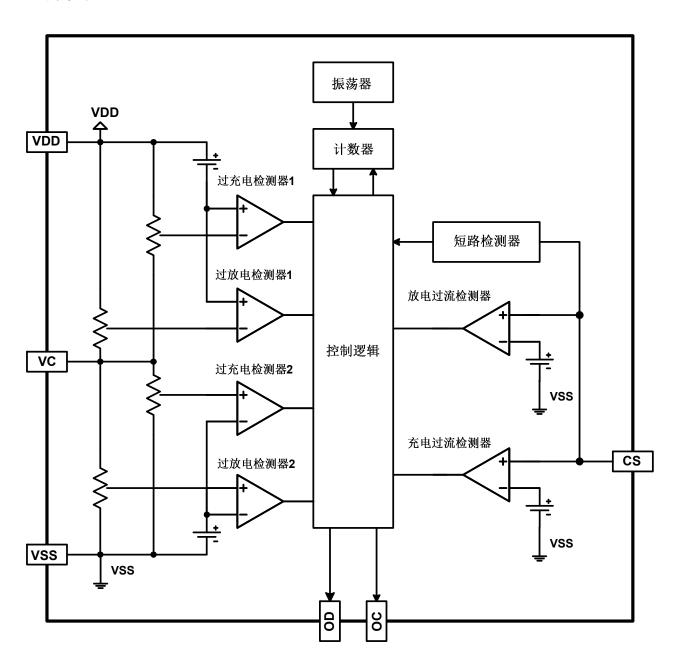
- (4) 连接充电器的端子采用高耐压设计(CS 端子和 OC 端子,绝对最大额定值是 33V)
- (5) 向 0V 电池充电功能:可以选择"允许"或"禁止"
- (6) 宽工作温度范围: -40℃~+85℃
- (7) 小型封装: SOT-23-6
- (8) HY2120 系列是无卤素绿色环保产品

3. 应用

- 2 节串联锂离子可再充电电池组
- 2 节串联锂聚合物可再充电电池组



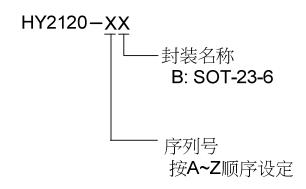
4. 方框图





5. 订货信息

■ 产品名称定义



6. 产品目录

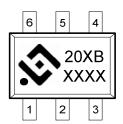
参数	过充电检测电	过充电释放	过放电检测	过放电释放	放电过流检	充电过流检	向 0V 电池
	压	电压	电压	电压	测电压	测电压	充电功能
型号	V _{CUn}	V _{CRn}	V _{DLn}	V _{DRn}	V _{DIP}	V _{CIP}	V _{0CH}
HY2120-AB	4.35±0.025V	4.15±0.05V	2.30±0.08V	3.00±0.1V	300±30mV	-210±30mV	允许
HY2120-BB	4.35±0.025V	4.15±0.05V	2.30±0.08V	3.00±0.1V	200±30mV	-210±30mV	允许
HY2120-CB	4.28±0.025V	4.08±0.05V	2.90±0.08V	3.00±0.1V	200±30mV	-210±30mV	允许
HY2120-DB	4.28±0.025V	4.08±0.05V	2.25±0.08V	2.95±0.1V	200±30mV	-210±30mV	允许
HY2120-EB	4.28±0.025V	4.08±0.05V	2.25±0.08V	2.95±0.1V	150±30mV	-210±30mV	允许
HY2120-FB	4.30±0.025V	4.10±0.05V	2.90±0.08V	3.00±0.1V	200±30mV	-210±30mV	允许
HY2120-GB	4.28±0.025V	4.08±0.05V	3.10±0.08V	3.20±0.1V	200±30mV	-210±30mV	允许

备注: 需要上述规格以外的产品时,请与本公司业务部联系。



7. 封装、脚位及标记信息

脚位	符号	说明
1	OD	放电控制用 MOSFET 门极连接端子
2	OC	充电控制用 MOSFET 门极连接端子
3	CS	过电流检测输入端子,充电器检测端子
4	VC	电池 1 负极、电池 2 正极连接端子
5	VDD	正电源输入端子,电池 1 正极连接端子
6	VSS	接地端,负电源输入端子,电池2负极连接端子



20: 产品名称

XB:产品序列号及封装名称

XXXX: 日期编码

8. 绝对最大额定值

(VSS=0V, Ta=25℃, 除非特别说明)

项目	符号	规格	单位
VDD 和 VSS 之间输入电压	V_{DD}	VSS-0.3~VSS+10	V
OC 输出端子电压	V _{oc}	VDD-33~VDD+0.3	V
OD 输出端子电压	V_{OD}	VSS-0.3~VDD+0.3	V
CS 输入端子电压	V _{CS}	VDD-33~VDD+0.3	V
工作温度范围	T _{OP}	-40~+85	$^{\circ}\!\mathbb{C}$
储存温度范围	T _{ST}	-40~+125	$^{\circ}\!\mathbb{C}$
容许功耗	P_D	250	mW



9. 电气特性

(VSS=0V, Ta=25℃, 除非特别说明)

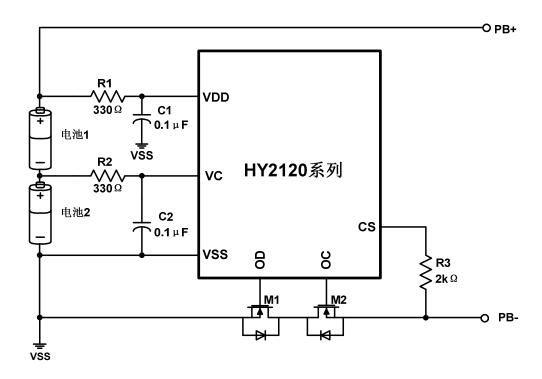
项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
		·····································	Ž			
VDD-VSS 工作电压	V_{DSOP1}	-	1.5	-	10	V
VDD-CS 工作电压	V_{DSOP2}	-	1.5	-	33	V
		 耗电流				
工作电流	I_{DD}	V _{DD} =7.8V	-	5.0	9.0	uA
休眠电流	I_{PD}	V _{DD} =4.0V	-	-	0.1	uA
		检测电压	ż			
过充电检测电压 n(*1)	V_{CUn}	4.1~4.5V,可调整	V _{CUn} -0.025	V_{CUn}	V _{CUn} +0.025	V
过充电释放电压 n(*1)	V_{CRn}	3.9~4.3V,可调整	V _{CRn} -0.05	V_{CRn}	V _{CRn} +0.05	V
过放电检测电压 n(*1)	V_{DLn}	2.0~3.2V,可调整	V _{DLn} -0.08	V_{DLn}	V _{DLn} +0.08	V
过放电释放电压 n(*1)	V_{DRn}	2.3~3.4V,可调整	V _{DRn} -0.10	V_{DRn}	V _{DRn} +0.10	V
放电过流检测电压	V_{DIP}		V _{DIP} -30	V_{DIP}	V _{DIP} +30	mV
负载短路检测电压	V_{SIP}	V_{DD} - V_{SS} =7.0 V	0.6	1.0	1.4	V
充电过流检测电压	V_{CIP}		V _{CIP} -30	V_{CIP}	V _{CIP} +30	mV
		延迟时间	J			
过充电检测延迟时间	T _{OC}		700	1000	1300	ms
过放电检测延迟时间	T _{OD}		70	110	150	ms
放电过流检测延迟时间	T_DIP		6	10	14	ms
充电过流检测延迟时 间	T _{CIP}		4	7	10	ms
负载短路检测延迟时 间	T _{SIP}		150	250	400	μs
		控制端子输出	出电压			
OD 端子输出高电压	V_{DH}		VDD-0.1	VDD-0.02		V
OD 端子输出低电压	V_{DL}			0.2	0.5	V
OC 端子输出高电压	V_{CH}		VDD-0.1	VDD-0.02		V
OC 端子输出低电压	V_{CL}			0.2	0.5	V
	1	句 0V 电池充电的功能	(允许或禁止)			
充电器起始电压(允许 向 0V 电池充电功能)	V _{och}	允许向 0V 电池充电功能	1.2	-	-	٧
电池电压(禁止向 0V 电池充电功能)	V _{OIN}	禁止向 0V 电池充电功能	-	-	0.5	V

备注:

*1. n=1, 2_°



10. 电池保护 IC 应用电路示例



标记	器件名称	用途	最小值	典型值	最大值	说明
R1	电阻	限流、稳定VDD、加强ESD	100Ω	330Ω	470Ω	*1
R2	电阻	限流、稳定VC、加强ESD	100Ω	330Ω	470Ω	*1
R3	电阻	限流	1 kΩ	2kΩ	4kΩ	*2
C1	电容	滤波,稳定VDD	0.01µF	0.1μF	1.0µF	*3
C2	电容	滤波,稳定VDD	0.01µF	0.1μF	1.0µF	*3
M1	N-MOSFET	放电控制	-	-	-	*4
M2	N-MOSFET	充电控制	-	-	-	*5

- *1、R1或R2连接过大电阻,由于耗电流会在R1或R2上产生压降,影响检测电压精度。当充电器反接时,电流从充电器流向IC,若R1或R2过大有可能导致VDD-VSS端子间电压超过绝对最大额定值的情况发生。
- *2、R3 连接过大电阻,当连接高电压充电器时,有可能导致不能切断充电电流的情况发生。但为控制充电器反接时的电流,请尽可能选取较大的阻值。
- *3、C1和C2有稳定VDD电压的作用,请不要连接0.01µF以下的电容。
- *4、使用MOSFET的阈值电压在过放电检测电压以上时,可能导致在过放电保护之前停止放电。
- *5、门极和源极之间耐压在充电器电压以下时,N-MOSFET有可能被损坏。

注意:

- 1. 上述参数有可能不经预告而作更改,请及时到网站下载最新版规格书。 网址: http://www.hycontek.com。
- 2. 外围器件如需调整,建议客户进行充分的评估和测试。



11.工作说明

11.1.正常工作状态

此 IC 持续检测连接在 VDD 与 VC 端子之间电池 1 的电压、连接在 VC 与 VSS 端子之间电池 2 的电压,以及 CS 与 VSS 端子之间的电压差,来控制充电和放电。当电池 1 和电池 2 的电压都在过放电检测电压(V_{DLn})以上并在过充电检测电压(V_{CUn})以下,且 CS 端子电压在充电过流检测电压(V_{CIP})以上并在放电过流检测电压(V_{DIP})以下时,IC 的 OC 和 OD 端子都输出高电平,使充电控制用 MOSFET 和放电控制用 MOSFET 同时导通,这个状态称为"正常工作状态"。此状态下,充电和放电都可以自由进行。

注意:初次连接电芯时,会有不能放电的可能性,此时,短接 CS 端子和 VSS 端子,或者连接充电器,就能恢复到正常工作状态。

11.2. 过充电状态

正常工作状态下的电池,在充电过程中,连接在VDD与VC端子之间电池1的电压或连接在VC与VSS端子之间电池2的电压,超过过充电检测电压(V_{CUn}),并且这种状态持续的时间超过过充电检测延迟时间(T_{OC})时,IC的OC端子输出电压由高电平变为低电平,关闭充电控制用的MOSFET(OC端子),停止充电,这个状态称为"过充电状态"。

过充电状态在如下两种情况下可以释放,OC端子输出电压由低电平变为高电平,使充电控制用 MOSFET导通。

- (1) 断开充电器,由于自放电使电池 1 和电池 2 的电压都降低到过充电释放电压(V_{CRn})以下时,过充电状态释放,恢复到正常工作状态。
- (2) 断开充电器,连接负载,当电池 1 和电池 2 的电压都降低到过充电检测电压(V_{CUn})以下时,过充电状态释放,恢复到正常工作状态。

注意:

①进入过充电状态的电池,如果仍然连接着充电器,即使电池 1 和电池 2 的电压都低于过充电释放电压(V_{CRn}),过充电状态也不能释放。断开充电器,CS 端子电压上升到充电过流检测电压(V_{CIP})以上时,过充电状态才能释放。

②当电池 1 或电池 2 的电压超过过充电检测电压(V_{CUn}),断开充电器并连接负载,如果电池 1 或电池 2 的电压仍不能降低到过充电检测电压(V_{CUn})以下,此时放电电流通过充电控制用 MOSFET 的寄生二极管流过,当电池 1 和电池 2 的电压都降低到过充电检测电压(V_{CUn})以下时,OC 端子输出电压由低电平变为高电平,使充电控制用 MOSFET 导通。

③当电池 1 或电池 2 的电压超过过充电检测电压(V_{CUn}),但在过充电检测延迟时间(T_{OC})之内,电池 1 和电池 2 的电压又降低到过充电检测电压(V_{CUn})以下,则此时不进入过充电保护状态。

④OC端子高电平是上拉到VDD端子, OC端子低电平是下拉到CS端子。

11.3. 过放电状态及休眠状态

正常工作状态下的电池,在放电过程中,连接在 VDD 与 VC 端子之间电池 1 的电压或连接在 VC 与 VSS 端子之间电池 2 的电压,降低到过放电检测电压(V_{DLn})以下,并且这种状态持续的时间超过过放电

2 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC



检测延迟时间(T_{OD})时,IC 的 OD 端子输出电压由高电平变为低电平,关闭放电控制用的 MOSFET (OD 端子),停止放电,这个状态称为"过放电状态"。

当关闭放电控制用 MOSFET 后,CS 由 IC 内部电阻上拉到 VDD,使 IC 耗电流减小到休眠时的耗电流值(<0.1uA),这个状态称为"休眠状态"。

过放电状态在以下两种情况下可以释放,OD 端子输出电压由低电平变为高电平,使放电控制用 MOSFET 导通。

- (1) 连接充电器,若 CS 端子电压低于充电过流检测电压(V_{CIP}),当电池 1 和电池 2 的电压都高于过放电检测电压(V_{DIP})时,过放电状态释放,恢复到正常工作状态。
- (2)连接充电器,若 CS 端子电压高于充电过流检测电压(V_{CIP}),当电池 1 和电池 2 的电压都高于过放电释放电压(V_{DRn})时,过放电状态释放,恢复到正常工作状态。

注意:

- ①当电池 1 或电池 2 的电压低于过放电检测电压(V_{DLn}),但在过放电检测延迟时间(T_{OD})之内,电池 1 和电池 2 的电压又回升到过放电检测电压(V_{DLn})以上,则此时不进入过放电保护状态。
 - ②OD 端子高电平是上拉到 VDD 端子, OD 端子低电平是下拉到 VSS 端子。

11.4. 放电过流状态(放电过流检测功能和负载短路检测功能)

正常工作状态下的电池,IC 通过检测 CS 端子电压持续侦测放电电流。一旦 CS 端子电压超过放电过流检测电压(V_{DIP}),并且这种状态持续的时间超过放电过流检测延迟时间(T_{DIP}),则 OD 端子输出电压由高电平变为低电平,关闭放电控制用的 MOSFET (OD 端子),停止放电,这个状态称为"放电过流状态"。

而一旦 CS 端子电压超过负载短路检测电压(V_{SIP}),并且这种状态持续的时间超过负载短路检测延迟时间(T_{SIP}),则 OD 端子输出电压也由高电平变为低电平,关闭放电控制用的 MOSFET (OD 端子),停止放电,这个状态称为"负载短路状态"。

放电过流状态和负载短路状态的释放,连接在电池正极(PB+)和电池负极(PB-)之间的阻抗大于 $450k\Omega$ (typ.)时。

另外,即使连接在电池正极(PB+)和电池负极(PB-)之间的阻抗小于 $450k\Omega$ (typ.)时,当连接上充电器,CS 端子电压降低到放电过流保护电压(V_{DIP})以下,也会释放放电过流状态或负载短路状态,回到正常工作状态。

11.5. 充电过流状态

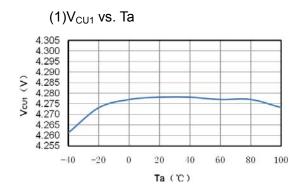
正常工作状态下的电池,在充电过程中,如果 CS 端子电压低于充电过流检测电压(V_{CIP}),并且这种状态持续的时间超过充电过流检测延迟时间(T_{CIP}),则 OC 端子输出电压由高电平变为低电平,关闭充电控制用的 MOSFET(OC 端子),停止充电,这个状态称为"充电过流状态"。

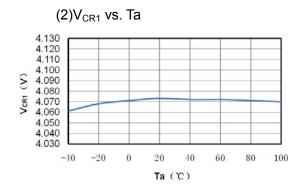
进入充电过流检测状态后,如果断开充电器使 CS 端子电压高于充电过流检测电压(V_{CIP})时,充电过流状态被解除,恢复到正常工作状态。



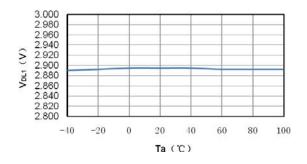
12.特性(典型数据)

12.1过充电检测电压/过充电释放电压,过放电检测电压/过放电释放电压,放电过流检测电压/负载短路检测电压,充电过流检测电压以及各延迟时间

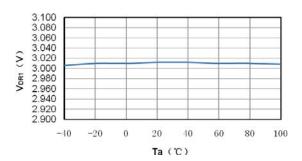


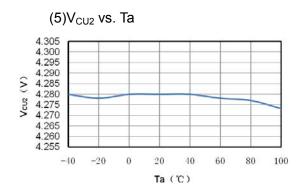


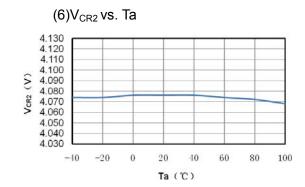






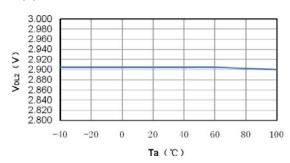




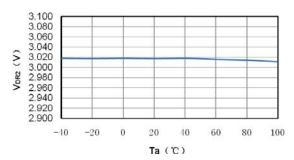




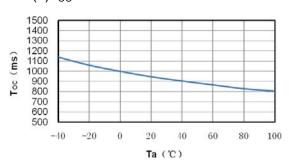
(7)V_{DL2} vs. Ta



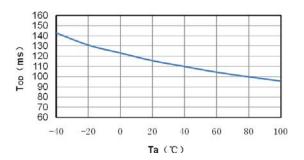
 $(8)V_{DR2}$ vs. Ta



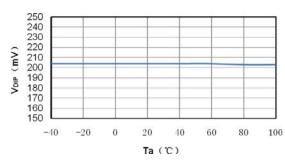
(9)T_{OC} vs. Ta



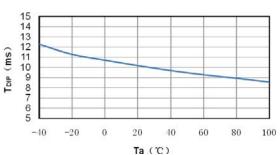
(10)T_{OD} vs. Ta



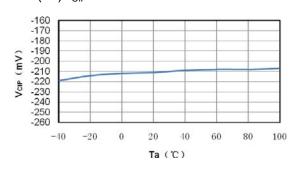
 $(11)V_{\text{DIP}}$ vs. Ta



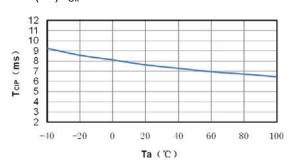
 $(12)T_{\text{DIP}}$ vs. Ta



(13)V_{CIP} vs. Ta

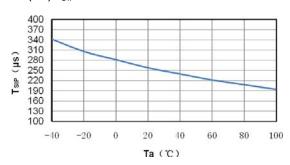


(14)T_{CIP} vs. Ta



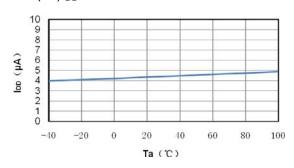




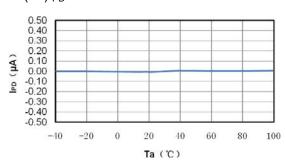


12.2 耗电流

(16)I_{DD} vs. Ta



(17)I_{PD} vs. Ta



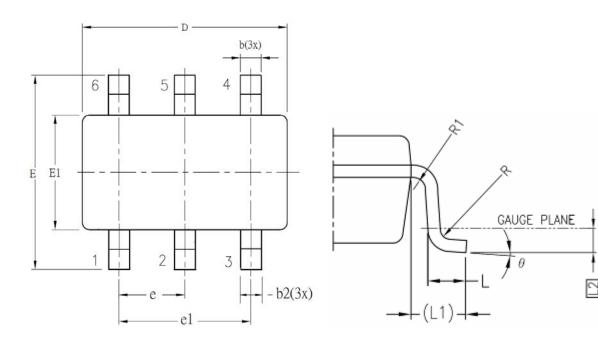


13.封装信息

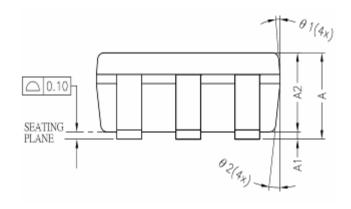
SOT-23-6 封装有两种不同尺寸规格。

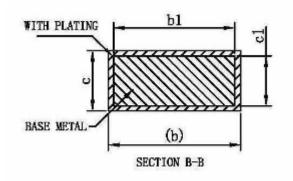
13.1.SOT-23-6 (第一种)

说明:单位为 mm。



SYM BOL		DIMENSION MILLIMETER	_
BOL	MINIMUM	NOMINAL	MAXIMUM
Α	ı	1.30	1.40
A1	0	ı	0.15
A2	0.90	1.20	1.30
b	0.30	ı	0.50
b1	0.30	0.40	0.45
b2	0.30	0.40	0.50
С	0.08	ı	0.22
c1	0.08	0.13	0.20
D		2.90 BSC	
Е		2.80 BSC	
E1		1.60 BSC	
е		0.95 BSC	
e1		1.90 BSC	
L	0.30	0.45	0.60
L1		0.60 REF	
L2		0.25 BSC	
R	0.10	-	-
R1	0.10	-	0.25
θ	0°	4°	8°
θ1	5° 5°	-	15°
θ2	5°	-	15°

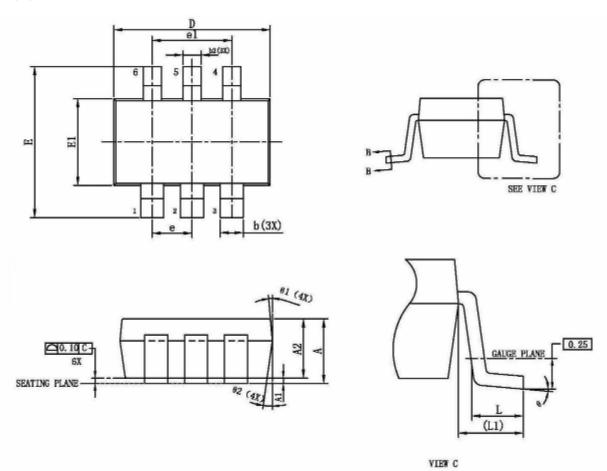




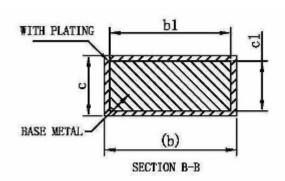


13.2.SOT-23-6 (第二种)

说明:单位为 mm。



SYM BOL		DIMENSION	
BOL	MINIMUM	NOMINAL	MAXIMUM
Α	-	1.30	1.40
A1	0.05	-	0.15
A2	0.90	1.20	1.30
b	0.40	-	0.55
b1	0.40	0.45	0.50
b2	0.25	-	0.40
С	0.08	-	0.20
c1	0.08	0.11	0.15
D	2.70	2.90	3.00
Е	2.60	2.80	3.00
E1	1.50	1.60	1.70
е		0.95 BSC	
e1		1.90 BSC	
٦	0.35	0.45	0.55
L1		0.60 REF	
θ	0°	5°	10°
θ1	3°	5°	7°
θ2	6°	8°	10°



2 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC



14. 修订记录

以下描述本文件差异较大的地方,而标点符号与字形的改变不在此描述范围。

版本	页次	变更摘要
V04	-	新版发行
V05	All	增加新型号 HY2120-CB
	15	修改封装尺寸
V06	All	增加新型号 HY2120-DB
V07	All	增加新型号 HY2120-EB
V08	7	修改 SOT-23-6 封装正印标记。
	12	更新"特性(典型数据)"。
V09	All	增加新型号 HY2120-FB
V10	All	增加新型号 HY2120-GB